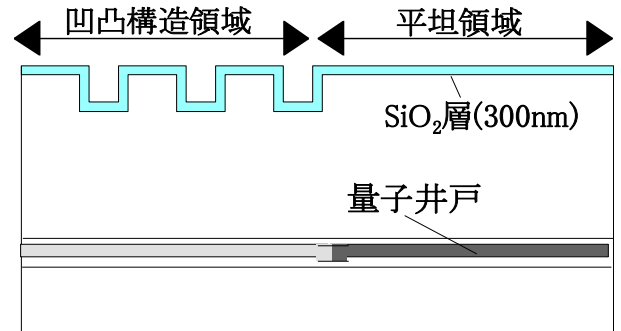
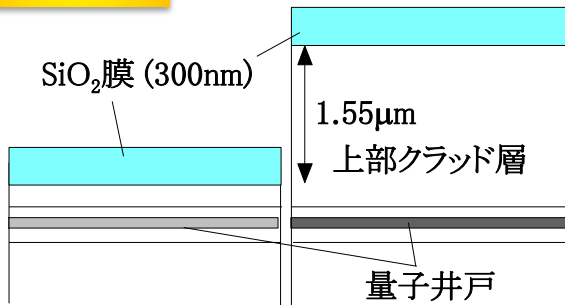


無不純物空孔拡散法とZn拡散法による

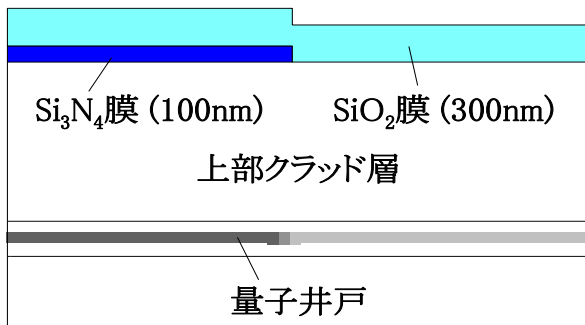
AlGaAs量子井戸の選択的無秩序化に関する研究

手法

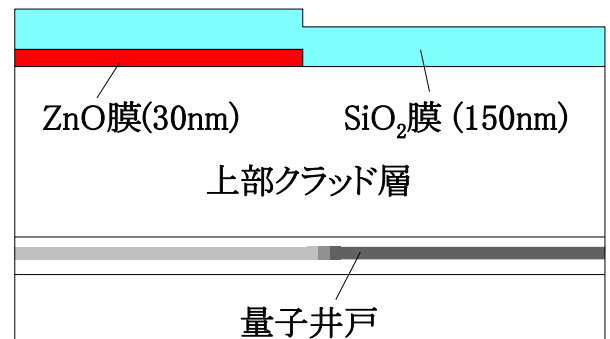


SiO₂キャップ膜と量子井戸との距離の差による選択的無秩序化

半導体とSiO₂キャップ膜との界面の面積差による選択的無秩序化



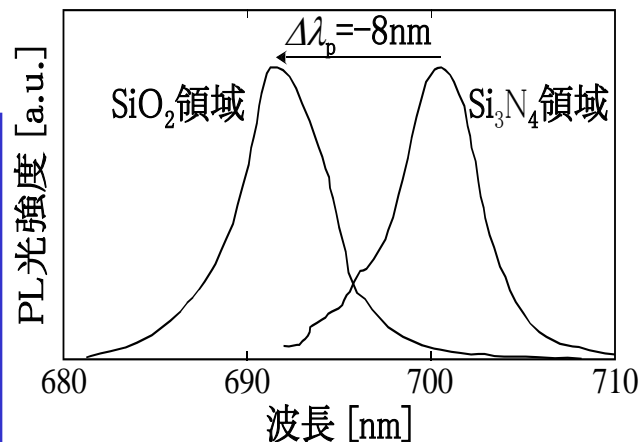
SiO₂膜とSi₃N₄膜を用いた選択的無秩序化



ZnO膜とSiO₂膜を用いた選択的無秩序化

評価

SiO₂膜とSi₃N₄膜を用いた選択的無秩序化について
フォトルミネッセンスピーク
波長差5~8nmの再現性の良い
選択的無秩序化が得られた。



フォトルミネッセンス測定結果